TEL

PRODUCT LINE-UP

東京エレクトロン 製品案内 2023



CLEAN TRACK

Featur

■ 低発塵新搬送方式 Low particle wafer transfer system

- 最新露光機を含めた リソセルとしてのOEE向上の実現 Improved Overall Equipment Efficiency (OEE) for litho cells
- 薬液コストの大幅な削減および 省エネルギー化Reduced Cost of Chemicals (CoC) and energy usage

■ リソグラフィー全般 All lithography processes



製造:東京エレクトロン九州(株) Mfg:Tokyo Electron Kyushu Ltd.

CLEAN TRACK LITHIUS Pro AP

■ ハイスループット/省フットプリント High throughput/Small footprint

■ OEE (Overall Equipment Efficiency) の改善 Improved OEE (Overall Equipment Efficiency)

■ 特殊ウェーハ対応 (反りウェーハ、ガラスウェーハ 貼り合わせウェーハ etc)

Special wafer support (warped wafer, glass wafer, bonded wafer etc.)



製造:東京エレクトロン九州(株) Mfg:Tokyo Electron Kyushu Ltd.

- アドバンスドパッケージプロセス Advanced packaging process
- ポリイミドプロセス Polyimide process
- SOG/SOD塗布プロセス SOG/SOD Coating process

Fe

CFLLESTA-i



Features

High throughput of up to 1,000 wafers per hour

Damage-free physical cleaning

新2流体スプレーによる using new atomizing spray

controls watermarks and pattern damage

Independent control of process environment in each chamber

Spinner technology compatible with various process chemistries

高スループット(最大毎時1,000枚)

ダメージレス物理洗浄

Unique drying technology that 🏺 ウォーターマーク、パターン倒壊を 抑制する独自乾燥技術

> チャンバーごとの プロセス雰囲気独立制御

各種アプリケーション対応 スピナー技術

Applications

Pre-diffusion and pre-CVD cleaning 卓 拡散前/CVD前洗浄

Post-etch cleaning 🏺 エッチング後洗浄

Wet etch

ウェットエッチング

Backside and bevel cleaning 🏺 裏面・ベベル洗浄

Post-etch polymer removal 🏺 配線加工ポリマー除去

オートウェットステーション **Auto Wet Station**

EXPEDIUS-i



Features

Transfer system with | 毎時1,000枚の搬送能力 throughput of 1,000wph

Short-time resist stripping

High selective and stable process for 3D NAND SiN etch process

New nozzle concept for etch

新ノズルコンセプトで槽内均一性 uniformity improvemet (WIW, WTW)

> Equipped with a stacked dual chamber dryer (SD2)

短時間レジスト剥離処理槽搭載可能

高選択比で安定的なプロセスを 提供する3D NAND向け SiN選択エッチング

(WIW、WTW)向上

SD2 (Stacked dual chamber dryer) 搭載

Applications

Wet-etch | Wet-etch (SiN etch, W recess, Poly Si etch)

Rework and recycle Rework/Recycle

Pre-diffusion and pre-CVD cleaning | Pre-diffusion、Pre-CVDクリーニング Post-etch cleaning and resist strip Post-etchクリーニング/Resist strip

(SiN etch, W recess, Poly Si etch)

Episode UL

■ フレキシブルなチャンバー数の 選択が可能

Flexible multi-chamber configurations

■ 最大12個のドライエッチチャンバー、 および後処理チャンバーを搭載可能

Support up to maximum 12 process chambers and after treatment chambers

■ 単位チャンバー当たりの フットプリントを削減 Offers significant reduction in footprint per chamber

■ Smart Tool機能を使用した 自律プロセス制御が可能

Enable autonomous process control with smart tool technology

TE Then

製造:東京エレクトロン宮城(株) Mfg:Tokyo Electron Miyagi Ltd.

■ 絶縁膜、シリコン、反応性イオンエッチング Dielectric, Conductor, Reactive Ion Etch

Tactras

■ 最大6個のドライエッチチャンバー および後処理チャンバーを

選択搭載可能 Support up to maximum

Support up to maximum 6 process chambers and after treatment chambers



■ 絶縁膜、シリコン、反応性イオンエッチング

Dielectric, Conductor, Reactive Ion Etch

製造:東京エレクトロン宮城(株) Mfg:Tokyo Electron Miyagi Ltd.

ガスケミカルエッチング装置 **Gas Chemical Etch System**

Certas LEAGA



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

Higher productivity with flexible module layout concept

> Selective etch for various oxide films

micro-loading and etch profile

カスタマイズ可能な モジュール構成による生産性向上

各種酸化膜に対する選択エッチング

Good controllability of
 粗密パターンでのローディング低減、 エッチング形状コントロールが可能

Dielectric 🎍 絶縁膜

Chemical dry etch | ケミカルドライエッチング

TELINDY PLUS[®]



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

Features

step coverage and high productivity

thin film controllability

High-speed robotics

Dry cleaning technology for particle reduction

consumption per wafer by decreasing L/L N2 flow rate and by higher throughput (SEMI S23 conversion, compared to TELINDY™)

Batch ALD process to achieve high

バッチ式ALDによりカバレッジ性能の 確保と高生産性を両立

Seed technology to achieve 🏺 シード技術によるCVD膜の 薄膜制御性の向上

■ 高速搬送メカ

■ ドライクリーニング技術による 微小パーティクル制御

31% reduction of energy 🕴 L/L N2流量削減、スループット向上 によりウェーハ当たりのエネルギー 消費量31%削減

(SEMI S23換算、TELINDY™比)

Applications

Oxide/Anneal/CVD/ALD . 成膜装置

(酸化/アニール/CVD/ALD装置)

NT333



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

Features

Thickness controllability at the monolayer level through sufficient gas adsorption and oxidation

High quality film deposition by taking quality improvement steps into ALD cycles

SiO₂ film deposited in low temperature regions (<400°C) has comparable HF etch resistance and leakage performance to thermal oxide

Enabling excellent film property uniformity required for high aspect ratio structures on 3D NAND devices at high temperatures (760°C) 反応ガスの十分な吸着・酸化による 原子レベルでの膜厚制御

ALDサイクル内への改質ステップ 組み込みによる高品質成膜の実現

低温域 (400度以下) において 熱酸化膜同等の耐フッ酸性、 リーク特性の実現

高温域(760度成膜)において 3D NANDに求められる 高アスペクト内の膜質均一性を達成

Applications

Various and dielectric films
Thermal and plasma configuration

高品質ALD Film プラズマ/サーマル

枚葉成膜装置 Single Wafer Deposition System





製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

Features

a high aspect ratio contact hole

superior step coverage at lower temperature with ASFD process

plasma processing using high density, low electron temperature plasma

Excellent step coverage at | 高アスペクトの微細ホールでの 高カバレッジ

Good film properties and | ASFDプロセスによる低温での 良好かつ高カバレッジな成膜

Low temperature and low damage | 高密度、低電子温度のプラズマを 利用した低温かつ低ダメージの プラズマ処理

Applications

CVD Ti/TiN/W | CVD Ti/TiN/W

ASFD TIN/TION/TISIN | ASFD TIN/TION/TISIN

Oxidation/Nitridation with plasma 🕴 プラズマ酸化/窒化

'ex

- 自動化オペレーション Automation of operations
- 高精度コンタクト High accuracy contact
- 高速インスペクション High-speed inspection
- 新オペレーションソフトウエアシステム New software structure
- プローブカード、ウェーハ安全機構 Advanced safety functions for probe card and wafer
- 製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)

Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

- 高発熱デバイス (HPC. GPU等) High heat generating device(HPC, GPU etc.)
- 狭ピッチ/小パッド、プロービング Small die and fine pitch probing
- 多ピン/多マルチ測定 High pin count and high multi-site SoC and memory
- フルウェーハテスト Full wafer testing
- 低ノイズ・パラメトリック測定 Low noise parametric probing

WDF 12DP+

- ダイシングフレームおよび標準ウェーハ全自動搬送対応
 - Fully automatic dicing frame and standard wafer handling
- COK/チェンジオーバーキットでの 容易な300/200mm切り替え Change over kit to easily switch between 300mm and 200mm
- "N-Shot" アライメントによる ダイシング後ウェーハへ高精度・ 多マルチプロービング

"N-Shot" alignment for high accuracy, parallelism probing for diced wafer

- 装置クリーン度、静電気対策改善 Improved system cleanliness and ESD*
- 製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.
- TEL標準ウェーハプローバアプリケーションソフトウエア"PSAS"対応 TEL standard prober application software "PSAS"
- ダイシング後テストによるKGD*保証、およびRMA* Post dicing test for KGD*, RMA*
- 先端パッケージテスト(WLP, FOWLP, Panel level package) Advanced package test capability(WLP, FOWLP, Panel level package)
- ダイシングシートに貼り付けられた薄ウェーハ、複数のPCB、ストリップフレームテスト Test for thin wafer, multiple PCB, strip frames on dicing frames *ESD: Electro Static Discharge *KGD: Known Good Die *RMA: Return Merchandise Authorization

reature:

マルチセルテストシステム **Multi-Cell Test System**

Cellcia



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

Features

Asynchronous and simultaneous test in each cell

完全に独立したセル構造による複数 ウェーハの同時テスト

Ultra-compact footprint by multi-layer 🏺 多段積み構造によるフットプリントの system structure

大幅削減

TAT reduction by simultaneous test 🍦 複数ウェーハ同時処理によりTAT in multiple cells

(Turn Around Time) 大幅短縮

wafer robot technology

応用した高信頼性搬送ロボット

Applications

300mm memory device 🕴 300mm メモリデバイス

Full wafer contact 🏺 フルウェーハー括コンタクト

Apps

- 高い稼動率を実現 High availability for production
- Cu Hvbrid接合の量産化を実現 Realized high volume manufacturing with Cu Hybrid bonding technology



Mfg:Tokyo Electron Kyushu Ltd.

- BSI用フュージョンボンディング Fusion bonding for BSI
- Cu Hybrid接合を利用するあらゆる製品に対応 Any application requires Cu Hybrid bonding

Synapse V / Synapse Z Plus

■ 本格量産用装置デザイン Designed for high volume manufacturing

■ 接合プロセスに要求される 材料塗布からウェーハ 接合までの一貫プロセスの実現 Realizes the entire temporary bonding process

■ 剥離プロセスでは35um厚までの ウェーハ剥離・洗浄・搬送を実現 Achieves debonding and handling of wafer with 35um or greater thickness



製造:東京エレクトロン九州(株) Mfg:Tokyo Electron Kyushu Ltd.

- 常温デボンディング技術の確立による高いプロセスマージンの実現 Establishes room temperature debonding process
- TSV用ウェーハ仮接合/剥離 Temporary bonding and debonding for TSV manufacturing
- 接着剤によるウェーハ永久接合 Wafer permanent bonding

Feature

バッチスプレー式洗浄装置 Batch Spray Cleaning System

ZETA"+

■ 省フットプリントで全自動搬送 Compact footprint with full automation

200/300mmの ウェーハサイズに対応 Available for 200mm and 300mm

■ 最大8種類の薬液と 加熱純水を使用可能 Up to 8 chemicals with built-in DI water heater

高温蒸気SPM処理 ViPR™プロセスによりウェーハ上 ~220℃で処理可能

High temperature stream SPM ViPR™ process enables processing at ~220°C on wafer



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America, Inc.

Apps

Feature:

■ FEOLウェット処理 FEOL wet steps

■ 水性BEOLウェット処理 Aqueous BEOL wet steps Si/SiC/AlTiC/Glass/Sapphire

MERCURY*+

- 低コスト/省フットプリント Low cost and compact footprint
- 200mm以下のウェーハサイズに対応 Available for wafer sizes 200mm and below
- 高度な欠陥検出機能を備えた 新しい制御システム New control system with advanced fault detection
- 高温ケミカル処理対応 High chemical temperature capability



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America, Inc.

Apr

Features

■ FEOLウェット処理 FEOL wet steps

■ 水性BEOLウェット処理 Aqueous BEOL wet steps ■ Si/SiC/AlTiC/Glass/Sapphire

ANTARES

■ 微小欠陥異物の高除去性能 High fall-on particle removal efficiency

純水、薬液を使用しない固体エアロゾル洗浄 Uses no water or chemicals

■洗浄時の対メタル膜腐食防止 Prevents metal attack and corrosion

■ 洗浄時の下地膜ダメージ防止 Will not etch or alter film properties

■ 純水洗浄で困難な疎水膜での洗浄可能 Ideal for hydrophobic films

■ DCプローブ洗浄 DC probe

reature:

Apps

■ FEOL High-k膜成膜後洗浄 FEOL High-k

■ BEOL絶縁膜成膜後洗浄 BEOL dielectric



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America, Inc.

■ BEOL CMP後洗浄 BEOL CMP

■ BEOLエッチング後パーティクル除去洗浄 BEOL RIE

スクラバー洗浄装置 Scrubber System

NS300+ 200mm Conversion

■ 8チャンバーによる高生産性 High productivity with 8 chambers

■ 進化したスクラバープロセステクノロジー Advanced scrubber process technology

■ システム・プロセスログ管理機能 Machine and process data management system

■ 表面/裏面・ベベル洗浄 Front/backside and bevel cleaning

■ 150/200mmのウェーハサイズに対応 Available for 150 and 200mm wafer



製造:東京エレクトロン九州(株) Mfg:Tokyo Electron Kyushu Ltd.

Featu

UltraTrimmer Plus

- GCIBによる表面の超平坦化機能 Super smooth surface flattening by GCIB
- 極薄表面改質機能(酸化·窒化)
 Ultra-thin surface modification function
- 膜厚データに基づくビーム照射制御 Beam irradiation control based on film thickness data
- 理想的な室温プロセス処理 Ideal room temperature process



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America, Inc.

- 100、150および200mmウェーハのうち2種類を段取り替えなしで対応可能 Enabling two of 100, 150 and 200mm wafer size handling without mechanical change
- RFフィルター(SAW、BAWおよびFBAR)の膜厚・周波数トリミング RF Filters (SAW, BAW and FBAR) thickness and frequency trimming
- MEMS、フォトマスクの表面平坦化
 Surface flattening on MEMS device and photo mask

縦型拡散/LP-CVD/ALD装置 Vertical Diffusion/LP-CVD/ALD Furnace System

ALPHA-8SEi

■ 長期サポートを見据えパーツ/ユニット/ コンポーネントを刷新

Renewed parts, units, and components for life extension

■ ALDプロセスに対応: HfO₂, Al₂O₃, SiO₂など

ALD process capability: HfO2, Al2O3, SiO2, and so on

■ 装置管理に最適な先進のモニタリング 機能

Advanced monitoring function for remote tool management

- Diffusion, LP-CVD, and ALD
- 150/200mmのウェーハサイズに対応 Available for 150 and 200mm wafer



Probus-SiC®

■ 高品質エピ膜を高い再現性で実現 A high quality epitaxial film is achieved with high repeatability

■ 高スループット&低ランニングコスト High throughput and low running cost

- チャンバー内Insituドライガスクリーニング 機能を搭載しメンテナンスサイクルを延長 In-situ dry gas cleaning system to extend preventive maintenance cycle
- 150/200mmのSiCウェーハに対応 150 and 200mm SiC wafer applicable
- SiC基板上へのエピタキシャル膜成膜SiC epitaxial film growth on SiC substrateSi面&C面&低オフ角基板、n型&p型、

厚膜エピ膜などに対応 Growth on Si face, C face and low off angle substrate, n-type and p-type film growth, thick film growth and others

TEL THE SPAN

Apps

製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

プラズマエッチング装置 Plasma Etch System

UNITY Me+

■ UNITY™ Meのプロセスチャンバーの 設計を変えずにメインコントローラー/ 搬送ロボットをアップデート

Update the main controller and transfer robot without changing the design of the UNITY™ Me process chambers

■ UNITY™ Me+とUNITY™ Me間の レシピ互換性を実現

Realize the process recipe compatibility between UNITY™ Me+ and UNITY™ Me

■ UNITY™ II eからのプロセストレース にも最適

Process trace from UNITY™ II e is also possible

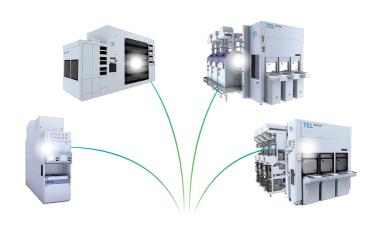
- Etching膜種: 絶縁膜、SiC/Si Etch layer: Dielectric, SiC/Si
- 100, 150, 200mm ウェーハ対応 100, 150, 200mm wafer applicable



製造:東京エレクトロン宮城(株) Mfg:Tokyo Electron Miyagi Ltd.

Feati

リモート接続による装置サポートサービス **TELeMetrics™ Remote/Support Service**



ELeMetrics

装置データへのリモート接続を基盤とするサービス

Services based on remote access to TEL equipment data



Remote Service

equipment data via remote access

Provide services by utilizing 🖕 リモートインフラを活用した サービスの提供

Remote troubleshooting | リモートトラブルシューティング

Alarm diagnosis 🏺 アラーム診断

Betelex

■ マルチチャンバーシステムを 採用(最大5基搭載可能) Multi-chamber system

5 chamber maximum

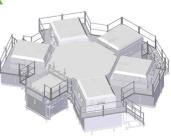
■ プロセスチャンバーモード: PICP™モード/PICP™ Proモード Chamber mode PICP™ mode/PICP™ Pro mode

■ 対応基板サイズ: 標準 Substrate size: Standard

1,500mm x 1,850mm



■ 絶縁膜エッチング Insulating layer etch



製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

- メタル膜エッチング Metal layer etch
- アッシング Photoresist ash

Impressio

■ マルチチャンバーシステムを 採用(最大3基搭載可能)

Multi-chamber system 3 chamber maximum

■ プロセスチャンバーモード: PICP™モード/ PICP™ Proモード/ECCPモード

Chamber mode: PICP™ mode/ PICP™ Pro mode/ECCP mode

■ 対応基板サイズ: 標準 Substrate size: Standard 1,500mm x 1,850mm |

製造:東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株) Mfg:Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.



■ シリコン膜エッチング Silicon layer etch

■ 絶縁膜エッチング Insulating layer etch ■メタル膜エッチング Metal layer etch

■ アッシング Photoresist ash

TEL PRODUCT LINE-UP

Japanese

www.tel.co.jp/product/

English

www.tel.com/product/













CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, EXPEDIUS, Episode, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, TELINDY, NT333, Triase*, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, ZETA, ViPR, MERCURY, ANTARES, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, Probus-SiC, UNITY, TELeMetrics, Betelex, PICP, Impressio, Exceliner, およびEliusは、東京エレクトロングループの日本およびその他の 国における登録商標または商標です。

CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, EXPEDIUS, Episode, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, TELINDY, NT333, Triase*, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, ZETA, ViPR, MERCURY, ANTARES, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, Probus-SiC, UNITY, TELeMetrics, Betelex, PICP, Impressio, Exceliner, and Elius are registered trademarks of Tokyo Electron Group in Japan and/or other countries.